

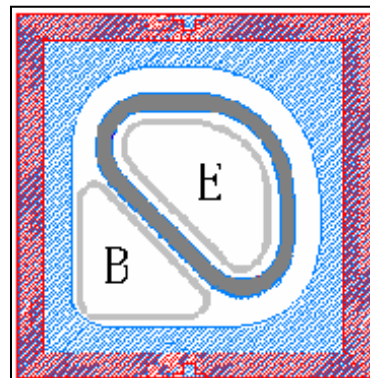


1015 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：A035BJ-01
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：350 × 350μm²
 焊位尺寸：B 极 12150μm² , E 极 16180μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SA1015 , H1015

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....400mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....-50V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-50V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....-5V
 I_C——集电极电流.....-150mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{CB} =-50V , I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{EB} =-5V , I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	70		700		V _{CE} =-6V , I _C =-2mA
		25				V _{CE} =-6V , I _C =-150mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.3	V	I _C =-100mA , I _B =-10mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-1.1	V	I _C =-100mA , I _B =-10mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-50			V	I _C =-100μA , I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-50			V	I _C =-1mA , I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-10μA , I _C =0
f _T	特征频率	80			MHz	V _{CE} =-10V , I _C =-1mA